

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN

CHỨC DANH: GIÁO SƯ

Mã hồ sơ:.....

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống:)

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ; Giảng viên thỉnh giảng

Ngành: Vật lý; Chuyên ngành: Vật lý Kỹ thuật

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên người đăng ký: Nguyễn Văn Hồng

2. Ngày tháng năm sinh: 28/02/1973; Nam ; Nữ ; Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:

4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: Xã Tân Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh): Phố Đoàn Thượng, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bru điện): Viện Vật lý Kỹ thuật, Phòng 116, nhà C10, Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1, Đường Đại Cồ Việt, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại nhà riêng: 0338162168; Điện thoại di động: 0338162168;

E-mail: hong.nguyenvan@hust.edu.vn

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):

Từ tháng, năm 11,2002 đến tháng, năm 07,2022: Giảng viên tại Viện Vật lý Kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Chức vụ hiện nay: Trưởng Bộ môn Vật lý Tin học, Viện Vật lý Kỹ thuật; Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng Bộ môn

Cơ quan công tác hiện nay: Viện Vật lý Kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Địa chỉ cơ quan: Phòng 116, Nhà C10, Đại Học Bách khoa Hà Nội, Số 1, Đường Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Điện thoại cơ quan: 02438693350

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): không

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ... năm ...

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ): không

9. Trình độ đào tạo:

- Được cấp bằng ĐH [3] ngày 31 tháng 05 năm 1999, số văn bằng: B 113181 , ngành: Vật lý Kỹ thuật, chuyên ngành: Vật liệu Điện tử; Nơi cấp bằng ĐH [3] (trường, nước): trường Đại học Bách khoa Hà Nội, TP Hà Nội, Việt Nam

- Được cấp bằng ThS [4] ngày 27 tháng 11 năm 2001, số văn bằng: 21170, ngành: Khoa học Vật liệu, chuyên ngành: Vật liệu Bán dẫn; Nơi cấp bằng ThS [4] (trường, nước): Trung tâm Quốc tế Đào tạo về Khoa học Vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội, TP Hà Nội, Việt Nam.

- Được cấp bằng TS [5] ngày 08 tháng 06 năm 2011, số văn bằng: 000607, ngành: Khoa học Vật liệu, chuyên ngành: Công nghệ Vật liệu Điện tử; Nơi cấp bằng TS [5] (trường, nước): trường Đại học Bách khoa Hà Nội, TP Hà Nội, Việt Nam.

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày 20 tháng 01 năm 2015, ngành: vật lý

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Hội đồng II: Vật lý, Luyện kim, Hóa học)

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Vật lý

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

Mô phỏng vi cấu trúc và tính chất của các hệ vật liệu có cấu trúc mất trật tự (vật liệu ở trạng thái vô định hình, trạng thái thủy tinh và trạng thái lỏng). Các nghiên cứu của ứng viên tập trung vào hai hướng sau:

- Nghiên cứu cấu trúc và động học của các hệ vật liệu ôxít

- Nghiên cứu cấu trúc mạng của các hệ vật liệu ôxít nhiều thành phần

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Đã hướng dẫn (số lượng) 5 NCS bảo vệ thành công luận án TS;

- Đã hướng dẫn (số lượng) ... HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận văn ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức danh GS không cần kê khai nội dung này);

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: 3 cấp Nhà nước; 1 cấp Bộ;

- Đã công bố (số lượng) 96 bài báo khoa học, trong đó 52 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín;

- Đã được cấp (số lượng) 0 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích;

- Số lượng sách đã xuất bản 5, trong đó 5 thuộc nhà xuất bản có uy tín;

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế: 0

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):

TT	Tên khen thưởng	Cấp khen thưởng	Năm khen thưởng
1	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2009-2010	Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội	2010

2	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2010-2011	Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội	2011
3	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2011-2012	Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội	2012
4	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2012-2013	Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội	2013
5	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2013-2014	Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội	2014
6	Chiến sĩ thi đua cấp bộ năm học 2013-2014	Bộ Giáo dục và đào tạo	2015
7	Bảng khen của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo năm học 2013-2014	Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo	2015
8	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2014-2015	Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội	2015
9	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2015-2016	Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội	2016
10	Bảng khen của Bộ Trưởng Bộ Khoa Học và Công Nghệ (giai đoạn 2011-2015)	Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ	2016
11	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2016-2017	Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội	2017

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết định):

TT	Tên kỷ luật	Cấp ra quyết định	Số quyết định	Thời hạn hiệu lực
Không có				

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:

- Luôn hoàn thành tốt công việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
- Luôn tự đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và luôn tận tâm giúp đỡ đồng nghiệp.

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 19 năm 8 tháng
- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS):

TT	Năm học	Số lượng NCS đã hướng dẫn		Số lượng ThS/CK2/BSNT đã hướng dẫn	Số đề án, khóa luận tốt nghiệp ĐH đã HD	Số giờ chuẩn gd trực tiếp trên lớp		Tổng số giờ chuẩn gd trực tiếp trên lớp/số giờ chuẩn gd quy đổi/số giờ chuẩn định mức (*)
		Chính	Phụ			ĐH	SDH	
1								
2								
3								
03 năm học cuối								
4	2019-2020				1	323.1	22.5	345,6 / 432,1 / 216

5	2020-2021				3	382.5	22.5	405 / 539,6 / 216
6	2021-2022					236.5	67.5	304 / 349,5 / 216

() - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.*

- Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu.

3. Ngoại ngữ

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh

a) Được đào tạo ở nước ngoài :

- Học ĐH ; Tại nước: ; Từ năm đến năm

- Bảo vệ luận văn ThS hoặc luận án TS hoặc TSKH ; Tại nước: năm

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước :

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: số bằng: ; năm cấp:

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài :

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: Tiếng Anh

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): Chương trình Tiên tiến, Viện khoa học và kỹ thuật vật liệu, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, (môn học: Mô phỏng mức nguyên tử (Atomic-scale simulation)); Viện Vật lý Kỹ thuật, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, (môn: Technical Writing and Presentation)

d) Đối tượng khác ; Diễn giải: - Thực tập sinh tại Đại học Công nghệ Nagaoka-Nhật bản trong thời gian 12 tháng (từ tháng 09/2007-08/2008), tham gia học 7 môn học theo chương trình Tiến sĩ (sử dụng tiếng Anh) và được cấp bằng điểm các môn học sau khi hoàn thành. - Tham dự khoá học ngắn hạn về “quản trị mạng máy tính” tại Trung tâm tính toán hiệu năng cao C-DAC, Ấn Độ trong thời gian 03 tháng (từ tháng 01/2006 đến 04/2006). Khoá học sử dụng tiếng Anh. Được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành các bài kiểm tra và bài thi kết thúc khoá học. Kết quả thi kết thúc khoá học được ghi trên Chứng chỉ. - Tham gia khoá đào tạo bồi dưỡng nâng cao kiến thức về năng lượng nguyên tử tại Hungary trong thời gian 06 tuần (từ ngày 09/09/2013 đến 20/10/2013). Khoá học sử dụng tiếng Anh. Được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành các bài thi kết thúc khoá học. - Tham gia nghiên cứu về năng lượng nguyên tử tại Đại học Công nghệ Nagaoka-Nhật Bản trong thời gian 03 tháng (từ 11/01/2016 đến 08/04/2016). Được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành bài báo cáo kết thúc khoá

học. Khoá học sử dụng tiếng Anh. - Sang thăm và hợp tác nghiên cứu với Viện RIKEN từ 16/03/-22/03/2015. - Visiting scientist tại Computational astrophysics Lab, Viện RIKEN, Nhật Bản từ 01/05/2015 đến 31/03/2017 (hàng năm được viện RIKEN tài trợ để có thể sang thăm và làm việc tại Computational astrophysics Lab từ 02-12 tuần). - Thăm và làm việc tại RIKEN 02 tháng (từ 02/09/2016 đến 28/10/2016). - Cho đến nay đã có 7 năm (từ năm 2015-nay) hợp tác nghiên cứu với Viện RIKEN-Nhật bản, hàng năm đều có từ 01-03 công trình khoa học được công bố chung với các nhà khoa học của Viện RIKEN. Các kết quả nghiên cứu hàng năm đều được thể hiện trong các báo cáo “Usage Report for Fiscal Year” của các năm.

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Chứng chỉ TOEFL 510 (năm 2005); Chứng chỉ C tiếng Anh (năm 2003); Chứng nhận tham gia khoá đào tạo về “Technical writing and presentation” được tổ chức ở ĐHBK HN từ ngày 03/09/ đến ngày 11/10 năm 2019.

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng

TT	Họ tên NCS hoặc HVCH/ CK2/ BSNT	Đối tượng		Trách nhiệm hướng dẫn		Thời gian hướng dẫn từ ... đến ...	Cơ sở đào tạo	Ngày, tháng, năm được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
		NCS	HVCH/ CK2/ BSNT	Chính	Phụ			
1	Mai Thị Lan	X		X		09/2013 đến 09/2015	Trường Đại học Bách khoa Hà Nội	16/12/2015
2	Nguyễn Văn Yên	X		X		05/2014 đến 05/2017	Trường Đại học Bách khoa Hà Nội	09/08/2018

3	Luyện Thị San	X		X		05/2014 đến 05/2017	Trường Đại học Bách khoa Hà Nội	05/06/2018
4	Trần Thuý Dương	X		X		05/2015 đến 05/2019	Trường Đại học Bách khoa Hà Nội	16/04/2020
5	Nguyễn Thị Thu Hà	X		X		05/2015 đến 05/2019	Trường Đại học Bách khoa Hà Nội	16/04/2020

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS.

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên

TT	Tên sách	Loại sách (CK, GT, TK, HD)	Nhà xuất bản và năm xuất bản	Số tác giả	Chủ biên	Phần biên soạn (từ trang ... đến trang)	Xác nhận của cơ sở GDDH (Số văn bản xác nhận sử dụng sách)
Trước khi được công nhận PGS/TS							

1	Linux Tiếp cận và thực hành	TK	NXB Y Học, năm 2003	6	VC	(Biên soạn chương 1, 2 và 3, Từ trang 1 đến trang 58)	
2	Windows NT & Windows 2000	TK	NXB Y Học, năm 2004	8	VC	(Biên soạn chương 6 và chương 7, từ trang 104 đến trang 156)	
3	Kỹ Thuật mô phỏng trong Vật lý	TK	NXB Đại học Sư phạm, năm 2014	5	VC	(Biên soạn chương 3, từ trang 100 đến trang 126 và phụ lục chương 3 từ trang 193 đến trang 206)	Xác nhận sử dụng sách của Viện Vật lý Kỹ thuật, ĐHBK Hà Nội

Sau khi được công nhận PGS/TS							
4	Cấu trúc của vật liệu oxit ở trạng thái lỏng	CK	NXB khoa học và kỹ thuật, năm 2020	2	VC	(Biên soạn chương 4 và chương 5, từ trang 115 đến trang 171)	Xác nhận sử dụng sách của Viện Vật lý Kỹ thuật, ĐHBK Hà Nội
5	Mô phỏng cấu trúc của các hệ ôxít bằng phương pháp mô phỏng động lực học phân tử	CK	NXB Đại Học Thái Nguyên, năm 2020	2	CB	(Biên soạn các chương 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ trang 1 đến trang 244)	Xác nhận sử dụng sách của ĐHBK Hà Nội

Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau PGS/TS: 1 ([5])

Lưu ý:

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có).

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang.... đến trang..... (ví dụ: 17-56; 145-329).

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu

TT	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)	CN/PCN/TK	Mã số và cấp quản lý	Thời gian thực hiện	Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm) / Xếp loại KQ
----	--	-----------	----------------------	---------------------	---

Trước khi được công nhận PGS/TS					
1	Mô phỏng quá trình khuếch tán trong hệ mất trật tự	CN	Đề tài Nafosted, mã số: 103.99-2011.22, cấp Nhà nước	01/12/2011 đến 01/12/2013	Biên bản họp đánh giá ngày 13/08/2013. Xếp loại kết quả: Đạt Nghiệm thu ngày 01/08/2014
2	Ứng dụng xử lý ảnh trong vật lý kỹ thuật	CN	Đề tài cấp Bộ Mã số: B2007.01.113, cấp Bộ	15/02/2007 đến 15/02/2009	Nghiệm thu ngày 27/02/2009. Xếp loại kết quả: Tốt
Sau khi được công nhận PGS/TS					
3	Nghiên cứu phân bố của các ô mạng sai hỏng trong hệ ôxít thủy tinh MOxSiO2 (M là Pb, Al, Mg, Ca hoặc Na)	CN	Đề tài Nafosted, mã số: 103.05-2014.40, cấp Nhà nước	01/03/2015 đến 01/03/2017	Biên bản họp đánh giá ngày 23/02/2017. Xếp loại kết quả: Đạt Nghiệm thu ngày 15/05/2017
4	Mô phỏng cấu trúc của hệ thủy tinh ô xít nhiều thành phần trên cơ sở B2O3-SiO2	CN	Đề tài Nafosted, mã số: 103.05-2018.38, cấp Nhà nước	01/12/2018 đến 01/12/2020	Biên bản họp đánh giá ngày 25/1/2021. Xếp loại kết quả: Đạt Nghiệm thu ngày 20/04/2021

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký.

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế):

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỹ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn (không tính tự trích dẫn)	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
Trước khi được công nhận PGS/TS								
1	Simulation study of polymorphism and diffusion anomaly for SiO ₂ and GeO ₂ liquid	2	Không	European Physical Journal B ISSN: 1434-6028	Tạp chí quốc tế uy tín - ISI IF: 1.4	8	71, 1, 105-110	08/2009
2	Local microstructure of silica glass	4	Không	Journal of Non-Crystalline Solids ISSN: 0022-3093	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI IF: 2.929	9	355, 22-23, 1215-1220	07/2009
3	Local structure of liquids Al ₂ O ₃ and GeO ₂ under densification	3	Không	Journal of Non-Crystalline Solids, ISSN: 0022-3093	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI IF: 2.929	6	354, 26, 3093-3097	03/2008
4	A study of pressure-induced polymorphism in liquid GeO ₂	4	Không	Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering, ISSN: 0965-0393	Tạp chí quốc tế uy tín - ISI IF: 1.826	1	15, 8, 845-854	10/2007

5	Diffusion and structure in silica liquid: a molecular dynamics simulation	3	Không	Journal of Physics: Condensed Matter ISSN: 0953-8984	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI <i>IF</i> : 2.707	19	19, 46, 466103(1-12)	04/2007
6	Sự phụ thuộc cấu trúc của hệ (Al ₂ O ₃).2(SiO ₂) lỏng vào áp suất	3	Có	Tạp chí khoa học & công nghệ các trường đại học kỹ thuật (ISSN: 0868-3980)			60, 5-9	06/2007
7	Simulation of local microstructure of amorphous alloys CoxB100-x	4	Không	Adv. In Tech. of Mat. and Mat proc. J (ATM, ISSN: 1440-0731)	- Hệ thống CSDL quốc tế khác		8, 1, 49-54	03/2006
8	Computer simulation of diffusion in amorphous solid	4	Không	Computational Physics: Proceeding of Joint Conference of ICCP6 and CCP2003 (416 pages, 10x7 inches, Jan 2005, Hardcover ISBN:1-58949-052-5)	- Hệ thống CSDL quốc tế khác		122-125	09/2004
9	Local microstructure of amorphous TiO ₂	5	Không	Communication in Physics (ISSN: 0868-3166)			18, 4, 217-224	05/2008

10	Computer simulation of the effects of phosphorous concentrations on microstructure in amorphous Co-P alloys	4	Không	Proceeding of Eighth German-Vietnamese Seminar on Physics and Engineering, Arlagen, 03-08 April 2005			200-203	04/2005
11	Computer simulation of amorphous and liquid Al ₂ O ₃	4	Không	Proceedings of the Seventh Vietnamese - German Seminar on Physics and Engineering, Halong City, March, 28 to April 5, 2004			317-320	04/2004
12	Simulation study on microstructure of liquid and amorphous SiO ₂	3	Không	Proceeding of the International Conference on Engineering Physics, Hanoi October 9-12, 2006			248-252	10/2006
13	Mô phỏng quá trình khuếch tán trong hệ mất trật tự	3	Không	Hội nghị vật lý toàn quốc lần thứ VI, Hà nội 23-25/11/2005			1059-1062	11/2005

14	Tính toán dải năng lượng trong vật liệu InxGa1-xN: độ cong nhỏ của năng lượng vùng cấm	6	Không	Hội nghị vật lý toàn quốc lần thứ VI, Hà nội 23-25/11/2005			113-116	11/2
15	Mô hình hoá quá trình khuếch tán trong hệ mất trật tự với sự trợ giúp của kỹ thuật tính toán song song	6	Không	Tạp chí khoa học & công nghệ các trường đại học kỹ thuật (ISSN: 0868-3980)			29, 19-23	04/2001
16	Mô hình hoá quá trình khuếch tán trong vật liệu vô định hình	5	Không	Hội nghị khoa học lần thứ 19, ĐHBK HN			59-65	10/2001
17	The study of energy levels in GaN/InxGa1-xN quantum well, quantum wires and quantum dots	7	Không	The Sixth German-Vietnamese Seminar on Physics and Engineering, Chemnitz, 25-31 May, 2003			204-207	03/2002

18	Investigation of local structure of amorphous alloys FexB100-x	7	Không	The Fifth Vietnamese-German Seminar on Physics and Engineering, Hue, 25 February-02 March, 2002			204-207	03/2002
19	Computer simulation of impurity diffusion in irons	6	Không	The Fifth Vietnamese-German Seminar on Physics and Engineering, Hue, 25 February-02 March, 2002			208-211	06/2002
20	Simulation of diffusion in canonical system	6	Không	The Fifth Vietnamese-German Seminar on Physics and Engineering, Hue, 25 February-02 March, 2002			212-215	06/2002
21	Polyamorphism and origin of spatially heterogeneous dynamics in network-forming liquids under compression: Insight from visualization of molecular dynamics data	4	Có	Appl. Phys. Lett., ISSN: 0003-6951	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI <i>IF</i> : 3.79	5	102,, 191908 (1-5)	05/2013

22	Correlation effect for dynamics in silica liquid	3	Không	Phys. Rev. E, ISSN: 1539-3755	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI IF: 2.326	1	86, 041508 (1-7)	10/2012
23	Dynamics and diffusion mechanism in network forming liquid under high pressure: A new approach	4	Có	Materials Chemistry and Physics, ISSN: 0254-0584	Tạp chí quốc tế uy tín - ISI IF: 2.129	1	138, 1, 154- 161	01/2013
24	Diffusion Mechanism in Liquid MgO: Insights from Simulation	3	Có	Brazilian Journal of Physics, ISSN: 0103-9733	Tạp chí quốc tế uy tín - ISI IF: 0.6		44, 1, 45-54	12/2013
25	Structural dynamics and diffusion mechanism in glass-forming liquid under high pressure	3	Có	Indian Journal of Physics, SSN: 0973-1458	Tạp chí quốc tế uy tín - ISI IF: 1.79	2	87, 9, 879- 887	05/2013
26	Structure and dynamics of liquid MgO under high pressure	3	Có	High Pressure Research (Taylor & Francis), ISSN 0895-7959	Tạp chí quốc tế uy tín - ISI IF: 0.926	2	32, 4, 509-523	10/2012

27	The Correlation between coordination and bond angle distribution in network-forming liquid	3	Có	Materials Science-Poland, ISSN: 2083-1331	Tạp chí quốc tế uy tín - ISI IF: 0.327		30, 2, 121-130	07/2012
28	The structure and dynamic in network forming liquids: Molecular dynamic simulation	3	Có	International Journal of Computational Materials Science and Surface Engineering, ISSN: 1753-3465	- Scopus IF: 0.17	1	5, 1, 55 - 67	09/2012
29	Study of blocking effect for diffusion in disordered lattice	3	Không	Journal of Non-Crystalline Solids, ISSN: 0022-3093	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI IF: 2.929	1	358, 8, 1141-1145	02/2012
30	Diffusion in one-dimensional disordered lattice	3	Không	Modern Physics Letters B, ISSN: 0217-9849	Tạp chí quốc tế uy tín - ISI IF: 0.687	1	26, 1, 1150011(1-12)	01/2012
31	About diffusion mechanism in silica liquid under pressure	3	Không	Journal of Non-Crystalline Solids, ISSN: 0022-3093	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI IF: 2.929	4	358, 14, 1649-1655	05/2012

32	Spatial heterogeneous distribution of $\text{SiO}_x \rightarrow \text{SiO}_{x \pm 1}$ reactions in silica liquid	4	Không	The Journal of Chemical Physics, ISSN: 0021-9606	Tạp chí quốc tế uy tín - ISI IF: 2.991	1	138, (24), 244505 (1-8)	06/2013
33	Computer simulation of diffusion in silica liquid under temperature and pressure	3	Không	European Physical Journal E, ISSN: 1292-8941	Tạp chí quốc tế uy tín - ISI IF: 1.802	4	36, 60, 1-8	06/2013
34	The structure and mechanical properties in amorphous alumina under pressure	4	Không	Computational Materials Science, ISSN: 0927-0256	Tạp chí quốc tế uy tín - ISI IF: 2.863	5	79 110-117	07/2013
35	Trực quan hóa dữ liệu mô phỏng động lực học phân tử đối với các chất lỏng cấu trúc mạng (SiO_2 , GeO_2 , Al_2O_3)	3	Không	Journal of science of HNUE, Natural Sci. ISSN: 0868-3719			58, 3, 141-148	06/2013

36	Mô phỏng vi cấu trúc và tính chất động học của oxit MgO lỏng dưới áp suất cao	3	Không	Tạp chí khoa học & công nghệ các trường đại học kỹ thuật ISSN: 0868-3980			91, 96-101	09/2012
37	Diffusion mechanism in liquid MgO under high pressure	3	Không	Journal of science of HNUE, Mathematical and Physical Sci., ISSN: 0868-3719			57, 7, 3-12	09/2012
38	Simulation microstructure of SiO ₂ and Al ₂ O ₃	4	Không	Tạp chí khoa học & công nghệ các trường đại học kỹ thuật, ISSN: 0868-3980			88, 118-123	04/2012
39	Polymorphism and diffusion for liquid aluminium silicate: a molecular dynamics simulation	3	Có	Tạp chí khoa học & công nghệ các trường đại học kỹ thuật, ISSN: 0868-3980			85, 99-104	03/2011
40	Computer Simulation of the Diffusion Processes in one-dimensional Disordered Systems	3	Không	Tạp chí khoa học & công nghệ các trường đại học kỹ thuật, ISSN: 0868-3980			82A, 90-94	10/2011

41	Influence of blocking effect and energetic disorder on diffusion in one-dimensional lattice	3	Không	Communications in Physics, (ISSN: 0868-3166)			24, 1, 85-96	03/2014
42	Polyamorphism and Structural Transformation in Liquid B ₂ O ₃ under Compression: Insight from Visualization of Molecular Dynamics Data	4	Không	VNU Journal of Mathematics – Physics, ISSN 2588-1124			30, 1, 32-38	03/2014
43	The Microstructure of Amorphous Iron Nanoparticle	4	Không	VNU Journal of Mathematics – Physics, ISSN 2588-1124			29, 3, 32-41	09/2013
44	The diffusion and spatial heterogeneous dynamic in liquid MgO – computer simulations via molecular dynamics	3	Không	International Conference on Advanced Materials and Nanotechnologies (ICAMN), Hanoi, Vietnam ISBN: 978-604-9111-247-8			121-127	11/2012

45	Studying blocking effect for many particles diffusion in one-dimensional disordered lattice	4	Không	Proc. Natl. Conf. Theor. Phys. 37			107-114	08/2012
46	The spatial heterogeneity and anomalous diffusivity in silica liquid	4	Không	Proc. Natl. Conf. Theor. Phys. 37			100-106	08/2012
47	Microstructure and Spatially Heterogeneous Dynamics in Network-forming Liquid under Compression	3	Không	International Conference on Advanced Materials and Nanotechnologies (ICAMN), Hanoi, Vietnam. ISBN: 978-604-911-247-8			43-48	11/2012
Sau khi được công nhận PGS/TS								

48	Coordination and polyamorphism of aluminium silicate under high pressure: insight from analysis and visualization of molecular dynamics data	4	Có	Can. J. Phys. ISSN: 1208-6045 (print); 0008-4204 (web)	Tạp chí quốc tế uy tín - ISI IF: 1.032	6	92, 12, 1573-1580	10/2014
49	Structural heterogeneity and dynamics in liquid PbSiO ₃ : insight from analysis and visualization of molecular dynamics data	4	Có	Materials research express, ISSN 2053-1591 (Online)	Tạp chí quốc tế uy tín - ISI IF: 1.914	1	2, 6, 065201(9 pp)	06/2015
50	Structural organization, micro-phase separation and polyamorphism of liquid MgSiO ₃ under compression	4	Có	Eur. Phys. J. B ISSN: 1434-6028	Tạp chí quốc tế uy tín - ISI IF: 1.347	6	89, 73, 1-10	03/2016

51	Polyamorphism of liquid silica under compression based on five order-parameters and two-state model: a completed and unified description	3	Có	High Pressure Research, ISSN: 0895-7959 (Print) 1477-2299 (Online)	Tạp chí quốc tế uy tín - ISI IF: 1.315	4	36, 2, 187-197	02/2016
52	Visualisation-based analysis of structure and dynamics of liquid aluminosilicate under compression	4	Có	Physics and Chemistry of Liquids, ISSN: 0031-9104 (Print) 1029-0451 (Online)	Tạp chí quốc tế uy tín - ISI IF: 1.56	6	55, 1, 62-84	04/2017
53	Pressure-induced structural changes in liquid MgSiO ₃	2	Không	JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE, Mathematical and Physical Sci. ISN: 0868-3719			60, 7, 62-67	12/2015
54	Pressure-dependent structural heterogeneity in calcium silicate glass,	5	Không	JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE, Mathematical and Physical Sci. ISN: 0868-3719			61, 7, 165-175	10/2016

55	About the diffusion mechanism in the silica liquid	5	Không	International Journal 1 of Modern Physics B, ISSN (print): 0217-9792 ISSN (online): 1793-6578	Tạp chí quốc tế uy tín - ISI IF: 0.863		30, 10, 1650059	04/2016
56	Structural properties of liquid aluminosilicate with varying Al ₂ O ₃ /SiO ₂ ratios: Insight from analysis and visualization of molecular dynamics data	4	Không	Modern Physics Letters B ISSN (print): 0217-9849 ISSN (online): 1793-6640	Tạp chí quốc tế uy tín - ISI IF: 0.731	6	31, 5, 1750036 (14 pages)	02/2017
57	Two state model and structural order in network forming liquid	3	Không	J. Science and Technology, 0868-3980			105, 62-65	04/2015
58	Two-domain structure and dynamics heterogeneity in a liquid SiO ₂	5	Không	Journal of Non-Crystalline Solids 124–131	Tạp chí quốc tế uy tín - ISI IF: 2.929	2	484 124-131	03/2018

59	Computer simulation of CaSiO ₃ glass under compression: correlation between Si-Si pair radial distribution function and intermediate range order structure	4	Không	Mater. Res. Express, ISSN 2053-1591 (Online)	Tạp chí quốc tế uy tín IF: 1.914	7	4, 6, 065201 (9 pages)	06/2017
60	The Structure of Liquid PbSiO ₃ : Insight from Analysis and Visualization of Molecular Dynamics Data	3	Không	VNU Journal of Science: Mathematics – Physics, , ISSN: 0866-8612			31, 3, 15-22	07/2015
61	Simulation Study of Void Aggregations in Amorphous ZnO	7	Không	Conference proceedings AETA 2016: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences, ISBN: 978-3-319-50904-4	- Hệ thống CSDL quốc tế khác		415 400-408	11/2016

62	The study of diffusion in network-forming liquids under pressure and temperature	4	Không	Physica B, ISN: 0921-4526	Tạp chí quốc tế uy tín - ISI IF: 1.902	1	501 18-25	07/2016
63	Insight into dynamics and microstructure of aluminum-silicate melts from molecular dynamics simulation	5	Không	Journal of Non-Crystalline Solids, ISSN: 0022-3093	Tạp chí quốc tế uy tín - ISI IF: 2.929	8	462 Page 1-9	01/2017
64	Network structure of SiO ₂ and MgSiO ₃ in amorphous and liquid States	4	Có	Mater. Res. Express, ISSN 2053-1591 (Online)	Tạp chí quốc tế uy tín - ISI IF: 1.914	6	4 035202, Page 1-9	03/2017
65	The first peak splitting of the Ge-Ge pair RDF in the correlation to network structure of GeO ₂ under compression	4	Có	Journal of Non-Crystalline Solids, ISSN: 0022-3093	Tạp chí quốc tế uy tín IF: 2.929	7	459 103-110.	03/2017

66	The role-change of Na^+ ions in sodium silicate system under compression, HNUE	4	Không	HNUE, JOURNAL OF SCIENCE, Natural Sciences, ISSN: 0868-3719			64, 6, 85-92	06/2019
67	Crystallization of amorphous silica under compression	4	Có	Can. J. Phys, ISSN: 1208-6045 (print); 0008-4204 (web)	Tạp chí quốc tế uy tín - ISI IF: 1.032		97 1133-1139	05/2019
68	structural, ferroelectric and energystorage properties of lead-free Zr-doped $BiO_{0.5}(Na_{0.8}K_{0.2})_{0.5}TiO_3$ films,	6	Không	Surface Review and Letters, ISSN (print): 0218-625X ISSN (online): 1793-6667	Tạp chí quốc tế uy tín - ISI IF: 0.835		27, 1, 1950082 (9 pages).	02/2020
69	Enhanced ferroelectric properties and energy storage density in PLZT/BNKT heterolayered thin films prepared by sol-gel method,	4	Có	Eur. Phys. J. B, ISSN: 1434-6028	Tạp chí quốc tế uy tín - ISI IF: 1.347	8	91, 316, (6 pages)	12/2018

70	Simulation of structural characteristics of Mullite melt at high pressure	3	Không	International Journal of Modern Physics B, ISSN (print): 0217-9792 ISSN (online): 1793-6578	Tạp chí quốc tế uy tín - ISI IF: 0.863		32, 24, 1850271 (20 pages)	08/2018
71	Pressure-induced structural change of CaO–Al ₂ O ₃ –SiO ₂ melt: Insight from molecular dynamics simulation	4	Có	Materials Chemistry and Physics ISSN 0254-0584	Tạp chí quốc tế uy tín - ISI IF: 3.408	4	236 121839 (11 pages)	10/2019
72	Topological analysis on structure and dynamics of SiO ₂ liquid with the help of Si-particle and O-particle statistics	4	Có	Mater. Res. Express, ISSN 2053-1591 (Online)	Tạp chí quốc tế uy tín - ISI IF: 1.914	2	6 085201, (11 pages)	05/2019
73	Structure and dynamical heterogeneity in GeO ₂ liquid: a new approach Eur.	4	Không	Eur, Phys. J. B , ISSN: 1434-6028	Tạp chí quốc tế uy tín - ISI IF: 1.347	1	92, 116, page 1-7	06/2019

74	The structural transition under densification and the relationship between structure and density of silica glass	5	Có	Eur. Phys. J. B, ISSN: 1434-6028	Tạp chí quốc tế uy tín - ISI <i>IF</i> : 1.347	3	92, 183, page 1- 7	08/2019
75	Computer simulation of local microstructure and dynamics in aluminumsilicate melt	4	Không	Modelling Simul. Mater. Sci. Eng. ISSN 0965-0393	Tạp chí quốc tế uy tín - ISI <i>IF</i> : 1.874		28 035008 (14 pp)	02/2020
76	Microstructure of lead silicate melt under compression: insight from computer simulation,	4	Có	Eur. Phys. J. B, ISSN: 1434-6028	Tạp chí quốc tế uy tín - ISI <i>IF</i> : 1.347	2	92, 268, Page 1- 14	12/2019

77	Network structure and dynamics heterogeneities in Al ₂ O ₃ system: insight from visualization and analysis of molecular dynamics data.	3	Không	Indian J Phys, ISSN: 0973-1458 (print); 0974-9845 (web)	Tạp chí quốc tế uy tín - ISI IF: 1.407	2	93 971-978	01/2019
78	Distribution of sodium and dynamical heterogeneity in sodium silicate liquid,	3	Không	International Journal 1 of Modern Physics B, ISSN (print): 0217-9792 ISSN (online): 1793-6578	Tạp chí quốc tế uy tín - ISI IF: 0.863		33, 5, 1950013 (12 pages)	02/2019
79	Densification mechanism of GeO ₂ glass under high pressure: Insight from analyzation and visualization of molecular dynamics data	5	Có	Computational Materials Science. ISSN: 0927-0256	Tạp chí quốc tế uy tín - ISI IF: 2.863	2	177 109597 (8 pages)	02/2020

80	The study of structure and dynamics of liquid Al ₂ O ₃ -2SiO ₂ at higher temperatures	3	Không	Phase Transitions, ISSN: 0141-1594 (Print) 1029-0338 (Online)	Tạp chí quốc tế uy tín - ISI IF: 1.04		93, 2, 274-286	01/2020
81	Topology of SiO _x -units and glassy network of magnesium silicate glass under densification: correlation between radial distribution function and bond angle distribution,	5	Có	Modelling Simul. Mater. Sci. Eng. ISSN 0965-0393	Tạp chí quốc tế uy tín - ISI IF: 1.874	2	28 065007 (30pp)	06/2022
82	Molecular dynamics simulation of amorphous silica under pressures	4	Không	Journal of Physics: Conference Series	Tạp chí quốc tế uy tín - ISI IF: 0.54		1506 012021 (12 pages)	06/2020

83	Structural organization in liquid PbSiO ₃ : insight from analysis and visualization of molecular dynamics simulation data	2	Có	The 2nd International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN) Hanoi, October 29th - November 1st, 2014, Hanoi, Vietnam.			Proceeding ICAMN-201 page 373-378	11/2014
84	Network structure and polymorphism of liquid CaSiO ₃ ,	2	Không	The 3rd International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN) Hanoi, October 2nd - 5th, 2016, Hanoi, Vietnam			Proceeding ICAMN-201 page 44-49	10/2016
85	Phase transition and crystallization of amorphous silica under high pressure	3	Không	The 3rd International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN) Hanoi, October 2nd - 5th, 2016, Hanoi, Vietnam			Proceeding ICAMN-201 page 11-15	10/2016

86	Structural simulation of amorphous PbSiO ₃ under compression	3	Không	The 3rd International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN), October 2nd - 5th, 2016, Hanoi, Vietnam			Proceeding ICAMN-201 page 16-21	10/2016
87	Study of (Al ₂ O ₃ -SiO ₂)-based Geopolymer materials with different composition using Molecular Dynamics simulation	4	Không	The 4th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN), October 13th to 16th, 2019, Hanoi, Vietnam			Proceeding ICAMN-201 page 64-69	10/2019
88	Local structure and diffusion mechanism in network forming liquid,	3	Có	The 4th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN), October 13th to 16th, 2019, Hanoi, Vietnam			Proceeding ICAMN-201 page 74-78	10/2019

89	Simulation of Network Structure and Polyamorphism of Borosilicate	2	Không	The 4th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN), October 13th to 16th, 2019, Hanoi, Vietnam			Proceeding ICAMN-201 page 92-97	10/2019
90	Polyamorphism and two state model in liquid GeO ₂ under compression: insight from visualization of molecular dynamics data	3	Không	Communications in Physics, ISSN: 0868-3166			24, 3S1, page: 95-98	11/2014
91	Structure and Correlation Between the Fraction of Structural Units and Bond Angle Distribution in Liquid B ₂ O ₃ Under Compression	2	Không	Journal of Applied Material Science & Engineering Research, ISSN 2689-1204	- Hệ thống CSDL quốc tế khác		2, 1, 1-5	04/2018

92	Structural and compositional heterogeneities in liquid aluminosilicate: insight from a grain structure model.	3	Có	Eur. Phys. J. B, ISSN: 1434-6028	Tạp chí quốc tế uy tín - ISI <i>IF</i> : 1.347	3	90, 37, 10 pages	02/2017
93	Insight into microstructure and dynamics of network forming liquid from the analysis based on shell-core particles	5	Không	Eur. Phys. J. B, ISSN: 1434-6028	Tạp chí quốc tế uy tín - ISI <i>IF</i> : 1.347	2	92, 166, 11 pages	08/2019
94	Structural transformation and dynamical heterogeneity in Germania melt under compression: molecular dynamic simulation	4	Không	Can. J. Phys. ISSN: 1208-6045 (print); 0008-4204 (web)	Tạp chí quốc tế uy tín - ISI <i>IF</i> : 1.24		99, 12, 9 pages	12/2021

95	Topological structural analysis and dynamical properties in MgSiO ₃ liquid under compression	7	Không	Eur. Phys. J. B, ISSN: 1434-6028	Tạp chí quốc tế uy tín - ISI <i>IF</i> : 1.34	95, 62, 11 pages	04/2022
96	Computer simulation of the glassy network structure of B ₂ O ₃ -2SiO ₂ and Al ₂ O ₃ -2SiO ₂ systems	2	Không	Journal of Physics: Conference Series	Tạp chí quốc tế uy tín <i>IF</i> : 0.48	2269 012010 (11 pages)	07/2022

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín mà UV là tác giả chính sau PGS/TS: 16 ([48] [49] [50] [51] [52] [64] [65] [67] [69] [71] [72] [74] [76] [79] [81] [92])

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (*Dành cho các chuyên ngành thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg*)

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Thuộc danh mục tạp chí uy tín của ngành	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
Không có							

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của ngành mà UV là tác giả chính sau PGS/TS:

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

TT	Tên bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích	Tên cơ quan cấp	Ngày tháng năm cấp	Tác giả chính/ đồng tác giả	Số tác giả

Không có

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp, là tác giả chính sau PGS/TS:

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao)

TT	Tên tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu TDTT	Cơ quan/tổ chức công nhận	Văn bản công nhận (số, ngày, tháng, năm)	Giải thưởng cấp Quốc gia/Quốc tế	Số tác giả
Không có					

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS:

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế:

TT	Chương trình đào tạo, chương trình nghiên cứu ứng dụng KHCN	Vai trò UV (Chủ trì/ Tham gia)	Văn bản giao nhiệm vụ (số, ngày, tháng, năm)	Cơ quan thẩm định, đưa vào sử dụng	Văn bản đưa vào áp dụng thực tế	Ghi Chú
-----------	--	---------------------------------------	---	---	--	----------------

1	Chương trình đào tạo cử nhân, kỹ sư ngành Vật lý kỹ thuật (Mã Ngành 72520401)	Tham gia	Phát triển chương trình đào tạo 2017 Ngành vật lý Kỹ thuật, Quyết định số 71/QĐ-ĐHBK-ĐTĐH ngày 03/05/2017 và Quyết định số 130/QĐ-ĐHBK-ĐT ngày 20/8/2020	Đại học Bách khoa HN	Phê duyệt bộ chương trình đào tạo tích hợp cử nhân thạc sĩ, số 111/ QĐ-ĐHBK-ĐT ngày 10/07/2020	Minh chứng gồm 2 file: 1/ danh sách thành viên hội đồng phát triển chương trình Vật lý Kỹ thuật; 2/ Văn bản phê duyệt đưa chương trình vào áp dụng thực tế
---	---	----------	---	----------------------	--	--

2	Chương trình đào tạo Thạc sĩ khoa học ngành Vật lý kỹ thuật (Mã số: 8520401)	Tham gia	Phát triển chương trình đào tạo 2017 Ngành vật lý Kỹ thuật, Quyết định số 71/QĐ-ĐHBK-ĐTĐH ngày 03/05/2017 và Quyết định số 130/QĐ-ĐHBK-ĐT ngày 20/8/2020	Đại học Bách khoa HN	Phê duyệt bộ chương trình đào tạo tích hợp cử nhân thạc sĩ, số 111/ QĐ-ĐHBK-ĐT ngày 10/07/2020	Minh chứng gồm 2 file: 1/ danh sách thành viên hội đồng phát triển chương trình Vật lý Kỹ thuật; 2/ Văn bản phê duyệt đưa chương trình vào áp dụng thực tế
---	--	----------	---	----------------------	--	--

	Viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo Vật lý Kỹ thuật theo chuẩn AUN-QA	Tham gia	Số 51/QĐ-ĐHBK-SEP ngày 20/05/2021	Đại học Bách khoa HN	Chương trình đào tạo ngành Vật lý kỹ thuật của ĐHBK HN đã đạt chuẩn AUN-QA	Tổ công tác viết báo cáo từ tháng 5/2021 và hoàn thành báo cáo vào tháng 12/2021. Tháng 4/2022, chương trình đã được tổ chức kiểm định AUN-QA đánh giá Đạt
--	---	----------	-----------------------------------	----------------------	--	--

9. Các tiêu chuẩn còn thiếu so với quy định cần được thay thế bằng bài báo khoa học quốc tế uy tín*:

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm: thiếu (số lượng năm, tháng):

b) Hoạt động đào tạo

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (UV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng):

- Giờ giảng dạy

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT:

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (UV chức danh GS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT (UV chức danh PGS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng ThS/CK2/BSNT bị

thiếu:

c) Nghiên cứu khoa học

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (UV chức danh GS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:

- Đã chủ trì không đủ 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (UV chức danh PGS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH ; 04 CTKH

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc UV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định:

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc UV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định:

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg.

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS)

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo:

- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo:

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

tỉnh Hải Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2022

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)